

## Übung 7 Elektronik I WS 08/09

1. Berechnen Sie die Ionisierungsenergie eines Donator- und Akzeptor-Atoms in **Ge** und **GaAs**. Unbekannte Größen finden Sie auf dem Hilfsblatt zur Vorlesung (<http://www.eus.uni-saarland.de>) und im Vorlesungsskript im Kapitel 2.3 in Tabelle 2.2 .
  
2. (a) Bestimmen Sie grafisch und mit Hilfe eines Rechnerprogramms (z. B. Octave, Matlab o. ä.) die Fermi-Energie eines dotierten **Si**-Halbleiters bei  $T = 300\text{ K}$ . Dabei gilt:  $N_A = 10^{11}\text{ cm}^{-3}$ ,  $N_D = 5 \cdot 10^{18}\text{ cm}^{-3}$ .  
(b) Um wieviel ändert sich  $W_F$  bei 100 K Temperaturerhöhung? Berücksichtigen Sie auch die Temperaturabhängigkeit der in die Näherungslösung eingegangenen Größen.
  
3. Silizium sei mit  $N_D = 10^{15}\text{ cm}^{-3}$  Donatoren dotiert, deren Donatoreniveaus 0,05 eV unter der Leitungsbandkante liegen. Berechnen Sie die Temperatur, für die  $n_0 = \frac{N_D}{2}$  ist.  
  
Hinweis: Es ergibt sich eine Gleichung, die nicht nach  $T$  auflösbar ist, aber numerisch leicht, z. B. mit MATLAB gelöst werden kann.
  
4. Wie groß ist bei Silizium die Besetzungswahrscheinlichkeit an der unteren Kante des Leitungsbandes bei  $T = 290\text{ K}$ , wenn das Fermi-Niveau
  - (a) in der Mitte des verbotenen Bandes liegt,
  - (b) 0,05 eV unter dem Leitungsband liegt?